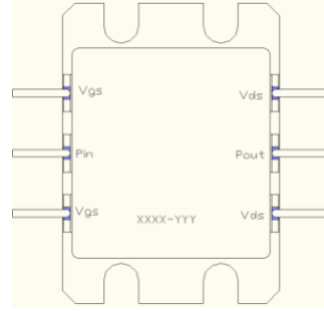


性能特点

- 工作频段: 0.87GHz~1.42GHz
- 输出功率: 55.5dBm (typ.)
- 功率增益: 13dB (typ.)
- 附加效率: 65% (typ.)
- 阻抗匹配:  $Z_{in}/Z_{out}=50\Omega$
- 封装形式: QF136GD



产品简介

HX0814P300WM是一种 GaN 内匹配宽带功率模块，可工作于连续波模式，在 50Ω 系统中提供最佳功率和增益性能。

最大额定值 (T<sub>C</sub> = +25°C)

指标	符号	极限值	单位
漏源电压	V <sub>DS</sub>	60	V
栅源电压	V <sub>GS</sub>	-6	V
存储温度	T <sub>stg</sub>	-65~+175	°C
沟道温度	T <sub>ch</sub>	225	°C

建议工作条件 (T<sub>C</sub> = +25°C)

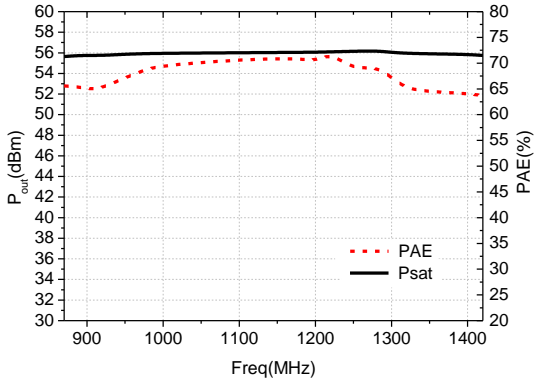
指标	符号	测试条件	极限值	单位
直流输入电压	V <sub>DS</sub>	48	≤32	V
存储温度	T <sub>stg</sub>	---	-65~+175	°C
沟道温度	T <sub>ch</sub>	---	175	°C

电参数 (T<sub>C</sub> = +25°C)

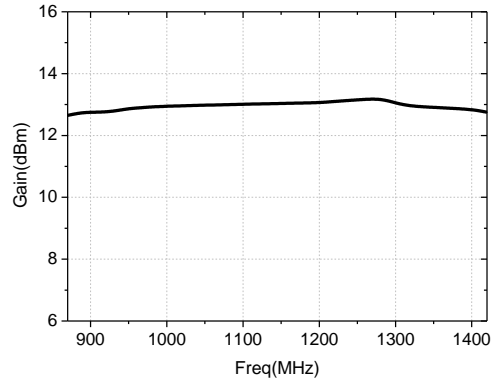
指标	符号	测试条件	极限值			单位
			最小值	典型值	最大值	
饱和输出功率	Psat	V <sub>DS</sub> =48V I <sub>DS</sub> = 0.2~2A f=0.87~1.42GHz, Z <sub>S</sub> =Z <sub>L</sub> =50Ω	54	55.5	-	dBm
功率增益	Gsat		12.5	13	-	dB
附加效率	PAE		60	65	-	%
增益平坦度	ΔG		-		±1.0	dB

典型曲线

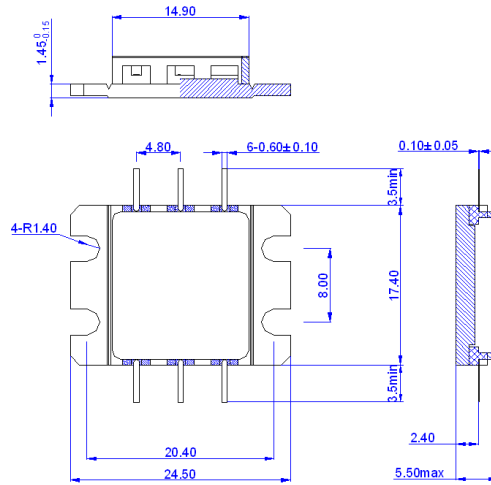
输出功率/效率 vs. 频率



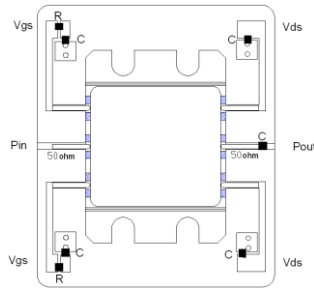
功率增益 vs. 频率



外形尺寸 (单位: mm)



典型使用电路图



注意事项

- 1) 本产品为内匹配型模块，输入输出阻抗为 50Ω；
- 2) 加电时请严格按先加栅压后加漏压的次序操作；
- 3) 使用过程中注意散热，推荐器件工作壳温不超过 75℃，过高会导致器件性能恶化，缩短使用寿命；
- 4) 本产品属于静电敏感器件，储存和使用中注意防静电，仪器、设备等应良好接地；
- 5) 不能触摸器件引线；
- 6) 用图示仪测量直流参数时，必须采取防振荡措施，否则易损坏器件，测试结果也不准确；
- 7) 辐照特性：本器件为辐照不敏感产品；
- 8) 有问题请与供货商联系。



静电敏感性器件  
请注意静电防护